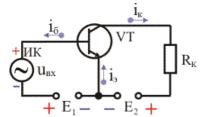
#### Билет 11

# **1.** Динамические характеристики биполярных транзисторов.

Конечное время движения носителей через базу создает эффект запаздывания. Что эквивалентно эффекту выходной емкости.



Возьмем схему с ОЭ.

Пустай входное напряжение отрицательно. Тогда закрытый переход подобен заряженному конденсатору.

Если в некоторый момент напряжение станет положительным, то в общем случае через сопротивление базы потечет ток (через прямо смещенный переход). При этом потребуется время на перезарядку емкостей эмиттера и коллектора, они образуют апериодические звенья.

Аналогично при обратном процессе. Емкости будут создавать эффект запаздывания.

Для оценки запаздывания используют формулу: tpac = $19*\tau$ /Iб

Iэ\*т – заряд на эмиттере

т – время жизни зарядов

Частота входного сигнала оказывает действие на h21э и определяется конечным временем жизни ностителей.

Может быть оценено формулой.

h21 $\ni$ (jw) = h21 $\ni$ (0)\*( $e^{(-j^*w^* \tau s)}/(1+j^*w^* \tau)$ 

 $\tau s = \tau / h219(0)$ 

Выводы – чем больше частота, тем больше уменшится h21э.

Частоту при которой этот коеф. уменшается в sqr(2) раз называется предельной частотой усиления. Для схемы с ОБ.

Для схемы с ОЭ часто используют граничную частоту, значение, когда h219 = 1.

## 2. РАСЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

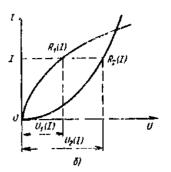
Метод пересечения характеристик (метод опрокинутой характеристики) используется для анализа цепей, которые методами эквивалентных преобразований могут быть сведены к последовательному включению двух элементов. В основу метода положено предположение о том, что суммарное напряжение на последовательно включенных элементах определяется внешним источником и не зависит от тока, протекающего в цепи. В соответствии со сказанным

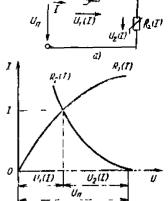
для цепи из двух элементов (рис. 4.10, а) справедливы выражения:

$$I = I_{R1} = I_{R2}, U_1(I) + U_2(I) = U_n.$$
(4.5)

При известных ВАХ элементов (рис. 4.10, 6) ток, удовлетворяющий системе (4.5), может быть легко найден графически. Для этого исходную характеристику одного из элементов зеркально отражают относительно оси токов (опрокидывают) и ее начало сдвигают по оси напряжений на величину, пропорциональную

Рис 410 Слема цепи (а). ВАХ печинейных этементов (б) и решение методом пересече иля характеристик (в)





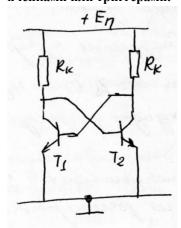
B)

входному напряжению цепи (отсюда и второе название метода — метод опрокинутой характеристики). Точка пересечения исходной характеристики одного и преобразованной характеристики второго элементов даст искомые ток I' и падения напряжений  $U_1(I)$  и  $U_2(I)$  (рис. 4.10,  $\theta$ ).

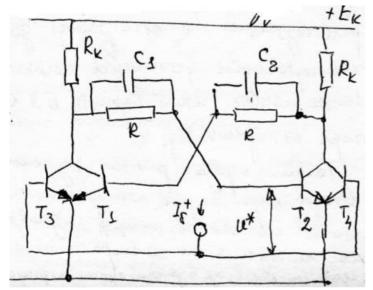
Используя описанный метод, легью исследовать процессы в целях как при изменении параметров элементов  $R_1(I)$  и  $R_2(I)$ , так и при изменении внешнего напряжения  $U_n$ .

### 3. Транзисторные Т-триггеры

Электронные схемы, имеющие 2 равноценных варианта устойчивых состояний, называются бистабильными ячейками или триггерами.



Бистабильные ячейки, предназначенные для работы в режиме общего входа, называют **Т-триггерами.** 



Для этого режима характерна подача управляющих сигналов одновременно на оба соединенных между собой входа БЯ, причем каждый очередной сигнал вызывает переход БЯ в состояние, противоположное предыдущему. Для того чтобы устойчивые состояния БЯ менялись регулярно после каждого входного импульса схема должна иметь внутреннюю память. Функция этой памяти состоит в том, чтобы хранить информацию о предыдущем состоянии триггера в течение всего времени действия очередного управляющего сигнала, a после окончания обеспечить принудительный переход схемы состояние, противоположное предыдущему.

# Для реализации внутренней памяти используют запоминающие емкости.

Пусть в исходном состоянии T1 заперт, а T2 открыт и насыщен. Тогда

 $I_{61} = 0$ 

 $I_{62} = (E_{\kappa} - U^*)/(R + R_{k})$ 

Соответственно напряжение на конденсаторах C1 и C2 будет

 $Uc_1 = I_{62} * R = (E_k - U^*) * R/(R + R_k)$ 

 $Uc_2 = I_{61} * 1 = 0$ 

Коллекторный потенциал Т1 будет

$$U_{k1}=U^*+I_{E\kappa}*R$$

При поступлении управляющего сигнала ключи Т3 и Т4 отпираются до насыщения. Тогда потенциал  $U_{k1}$  падает практически до нуля, а потенциал  $U_{62}$  оказывается отрицательным

$$U_{62} = U_{k1} - U_{c1} = U_{c1}$$

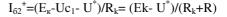
Опа транзистора Т1 и Т2 остаются запертіми до окончания входного сигнала.

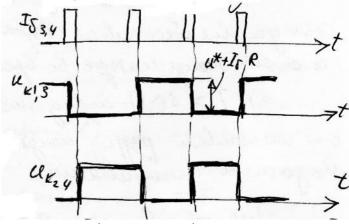
В овремя действия сигнала C1 разряжается через резистор R

С постоянной времени  $au_c$ =C1\*R. Если длительность сигнала достаточно мала ( $t_{\rm Bx}$  =<  $au_c$ ), то разряд незначителен и напряжение  $U_{\rm c1}$  сохраняет свое исходное значение.

По окончании сигнала в базы транзисторов поступают отпирающие токи, которые имеют существенно разные значения

$$I_{61}^{+}=(E_{\kappa}-Uc_{2}-U^{*})/R_{k}=(Ek-U^{*})/R_{k}$$





Очевидно ток  ${\rm I_{61}}^+$  больше тока  ${\rm I_{62}}^+$ 

Соответственно скорость нарастания коллекторного тока в Т1 больше, чем вТ2. Быстро нарастающий ток в Т1 ответвляясь в базу Т2 подавляет начальное значение  ${\rm I_{62}}^+$ . В результате Т2 заперт, а Т1 через некоторое время входит в режим насыщения.

Тем самым триггер изменил свое первоначальное состояние. В промежутке между входными сигналами С1 успеет разрядиться, а С2 – зарядиться (до того же напряжение которое в исходном состоянии было на С1). Поэтому при поступлении очередного входного сигнала процессы будут развиваться аналогично и БЯ вернется в исходное состояние.

Таким образов конденсаторы сохраняют те напряжения, которые свойственны предыдущему состоянию триггера. Обеспечивают однозначную искусственную асимметрию отпирающих токов в момент окончания входного сигнала и тем самым переход БЯ в начальное состояние.

Для работы Т-триггера достаточно выделить два условия:

$$t_{\rm BX} = < \tau_{\rm C}$$

тут  $\tau_c$  — постоянная времени емкости. Это условие обеспечивает сохранения напряжение на запоминающем конденсаторе во время действия входного импульса

2)T>3\* 
$$\tau_c$$

(T – период повторения импульсов) Это условие обеспечивает разряд конденсатора в промежутке между входными импульсами.

Все это в целом ограничивает быстродействие системы